

บทที่ 2

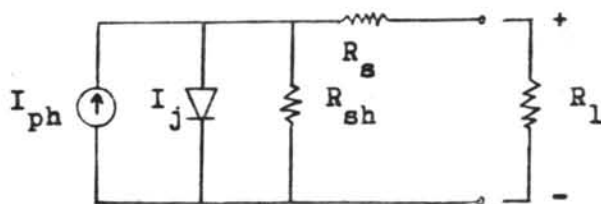
แถวของเซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการโฟโตโวลตาอิก เพื่อเปลี่ยนรูปของพลังงานจากพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ได้เริ่มมีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์มานานหลายสิบปีแล้ว เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันมีราคาแพง การพัฒนาเทคนิคการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ก็มีขึ้นอย่างมาก เพื่อที่จะให้ได้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาอยู่ในเกณฑ์ที่จะซื้อขายกันได้ ในปี พ.ศ. 2525 เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขายในประเทศไทยของเราราคาประมาณ 300 บาทต่อกำลังงานสูงสุดหนึ่งวัตต์ จากเซลล์แสงอาทิตย์ และทำเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งโดยมากเป็นเซลล์แสงอาทิตย์หลาย ๆ เซลล์ต่อกัน เซลล์แสงอาทิตย์ที่จะกล่าวต่อไปในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นเซลล์ที่มีขายแพร่หลายในห้องทดลอง คือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอน ซึ่งถูกนำมาใช้ในการทดลองเรื่องระบบสูบน้ำขนาดเล็กนี้ด้วย

วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์ถูกแทนด้วยวงจรสมมูลในทางวิศวกรรมไฟฟ้า [1] ได้ดังภาพที่ 2.1 เพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์มีคุณสมบัติของไดโอดอยู่ด้วยนั้นเกิดจากรอยต่อ พี-เอ็น หรือรอยต่อ เอ็น-พี ของซิลิกอน



ภาพที่ 2.1 วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์

- I_{ph} คือ กระแสที่เกิดจากแสงตกกระทบบนเซลล์แสงอาทิตย์
- I_j คือ กระแสที่ผ่านรอยต่อ พี - เอ็น หรือ เอ็น - พี ของซิลิกอน

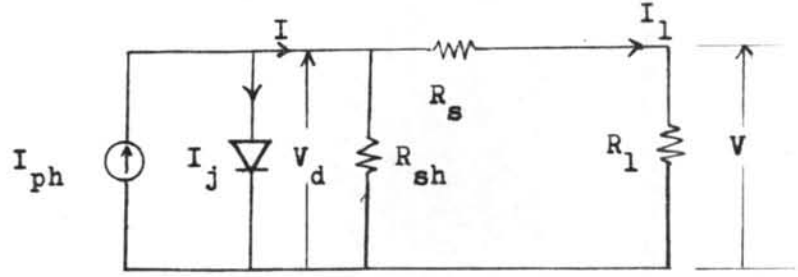
ในทิศทาง ตรงข้ามกับกระแสที่ไหลออกมาจากเซลล์

- R_s คือ ความต้านทานอนุกรมของเซลล์แสงอาทิตย์
- R_{sh} คือ ความต้านทานขนานของเซลล์แสงอาทิตย์
- R_1 คือ ความต้านทานของภาระไฟฟ้าที่ต่อกับสองขั้วของเซลล์แสงอาทิตย์
- I_1 คือ กระแสที่ผ่านความต้านทาน R_1

สมการของเซลล์แสงอาทิตย์

ในการวิเคราะห์การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์นั้น ต้องการสมการที่จะแสดงคุณลักษณะของกระแสและแรงดันที่เกิดขึ้นกับเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อภาระทางไฟฟ้า (R_1) ของเซลล์แสงอาทิตย์ และค่าการรับรังสีเปลี่ยนแปลงไป

ค่าการรับรังสี (Solar irradiance or insolation) หมายถึง ค่าพลังงานของแสงอาทิตย์ที่ตกลงบนพื้นที่หนึ่งตารางหน่วย อาจใช้หน่วยมิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร หรือวัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งในที่นี้จะใช้หน่วยอย่างหลัง



ภาพที่ 2.2 วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีภาระไฟฟ้าต่อยู่

เมื่อพิจารณาภาพที่ 2.2 ภาระไฟฟ้าต่อยู่กับเซลล์แสงอาทิตย์แล้วย่อมเกิดกระแส I_1 ไหลผ่าน R_1

- V คือ แรงดันคร่อม R_1 หน่วยเป็นโวลต์
- I_1 คือ กระแสผ่าน R_1 หน่วยเป็นแอมแปร์

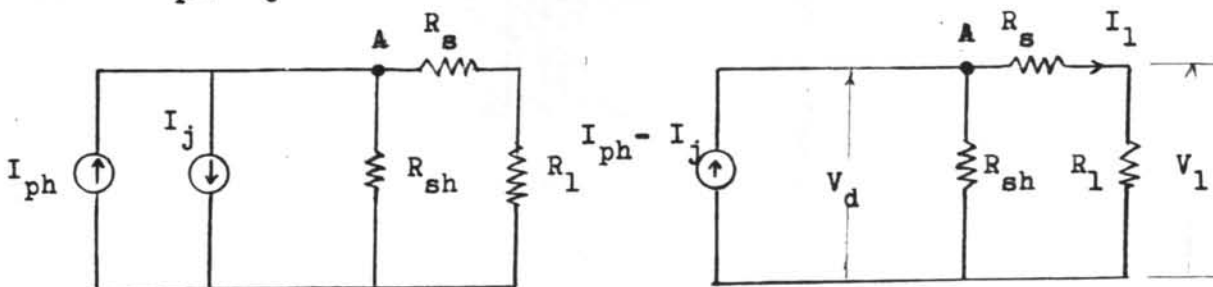
- V_d คือ แรงดันที่รอยต่อของซิลิกอนไดโอดขณะไบแอสตรง (Forward-biased diode voltage) หน่วยเป็นโวลต์
- I_o คือ กระแสไหลกลับอิ่มตัวของไดโอด (Reverse saturation current of diode) หน่วยเป็นแอมแปร์
- A คือ q/AKT หน่วยเป็น (โวลต์)⁻¹
- q คือ ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน 1 ตัว คือ 1.602×10^{-19} คูลอมบ์
- K คือ ค่าคงที่โบลท์ซแมน คือ 1.38×10^{-23} จูลต่อองศาสัมบูรณ์
- T คือ อุณหภูมิของเซมิคอนดักเตอร์ หน่วยเป็นองศาสัมบูรณ์
- V_t คือ แรงดันจากความร้อน (Thermal voltage)
- $V_t = \frac{KT}{q}$ หน่วยเป็นโวลต์
- A คือ แฟกเตอร์แห่งความสมบูรณ์แบบ (Junction perfection factor)

จากคุณสมบัติของไดโอด

$$I_j = I_o (e^{\lambda V_d} - 1) \dots\dots\dots (2.1)$$

$$\lambda = \frac{1}{AV_t}$$

เมื่อพิจารณาภาพที่ 2.2 และมอง I_j ที่ผ่านรอยต่อของไดโอดเป็นเหมือนกระแสจากแหล่งจ่ายกระแส (current source) ที่ขนานอยู่กับแหล่งจ่ายกระแส I_{ph} ดังภาพที่ 2.3 ก. จากนั้นรวมแหล่งจ่ายกระแส I_{ph} และ I_j เข้าด้วยกัน เป็นแหล่งจ่ายกระแส $I_{ph} - I_j$ ดังภาพ 2.3 ข. คิดตามกฎของเคอร์ชอฟที่จุด A.



ก.

ข.

ภาพที่ 2.3 วงจรใช้หาสมการของเซมิคอนดักเตอร์

$$\begin{aligned}
 I_{ph} - I_j &= \frac{V_d}{R_{sh}} + I_1 \\
 &= \frac{V_1 + I_1 R_s}{R_{sh}} + I_1 \\
 &= \frac{V_1}{R_{sh}} + I_1 \left(1 + \frac{R_s}{R_{sh}}\right)
 \end{aligned}$$

เมื่อกำหนดให้ $\beta = 1 + \frac{R_s}{R_{sh}}$

$$I_{ph} - I_j = \frac{V_1}{R_{sh}} + \beta I_1 \quad \dots\dots\dots (2.2)$$

แทนค่า I_j จากสมการที่(2.1) ในสมการที่(2.2)

$$I_{ph} = \frac{V_1}{R_{sh}} + \beta I_1 + I_o (e^{\lambda V_d} - 1)$$

$$e^{\lambda V_d} = \left[\frac{I_{ph} - \beta I_1 - \frac{V_1}{R_{sh}}}{I_o} \right] + 1$$

$$V_d = \frac{1}{\lambda} \ln \left[\frac{I_{ph} - \beta I_1 - \frac{V_1}{R_{sh}}}{I_o} + 1 \right]$$

เพราะว่า $V_d = V_1 + I_1 R_s$

$$\therefore V_1 = -I_1 R_s + \frac{1}{\lambda} \ln \left[\frac{I_{ph} - \beta I_1 - \frac{V_1}{R_{sh}}}{I_o} + 1 \right] \dots\dots(2.3)$$

ถ้า R_{sh} มีค่ามาก ๆ สมมติว่า $R_{sh} \rightarrow \infty$

$$V_1 = -I_1 R_s + \frac{1}{\lambda} \ln \left[\frac{I_{ph} - \beta I_1}{I_o} + 1 \right]$$

คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์อย่างหนึ่ง คือ กระแสลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์นั้น จะแปรตามค่าการรับรังสี [2]

เมื่อ I_{sc} คือ กระแสลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์ และ δ คือ ค่าการรับรังสี

$$\begin{aligned} I_{sc} &\propto \phi \\ \phi &\propto I_{sc} \\ \phi &= K_{ph} I_{sc} \end{aligned}$$

K_{ph} คือ ค่าคงที่ขณะเซลล์แสงอาทิตย์ถูกลัดวงจร วัดที่อุณหภูมิคงที่หนึ่ง ๆ และคิดโดยประมาณ

$$\begin{aligned} I_{ph} &= \beta I_{sc} \\ \therefore I_{ph} &= \beta \phi / K_{ph} \end{aligned}$$

แทน I_{ph} ในสมการที่ (2.3)

$$V_1 = -I_1 R_s + \frac{1}{\lambda} \ln \left[\frac{\beta \phi / K_{ph} - \beta I_1 - V_1 / R_{sh}}{I_0} + 1 \right] \dots \dots (2.4)$$

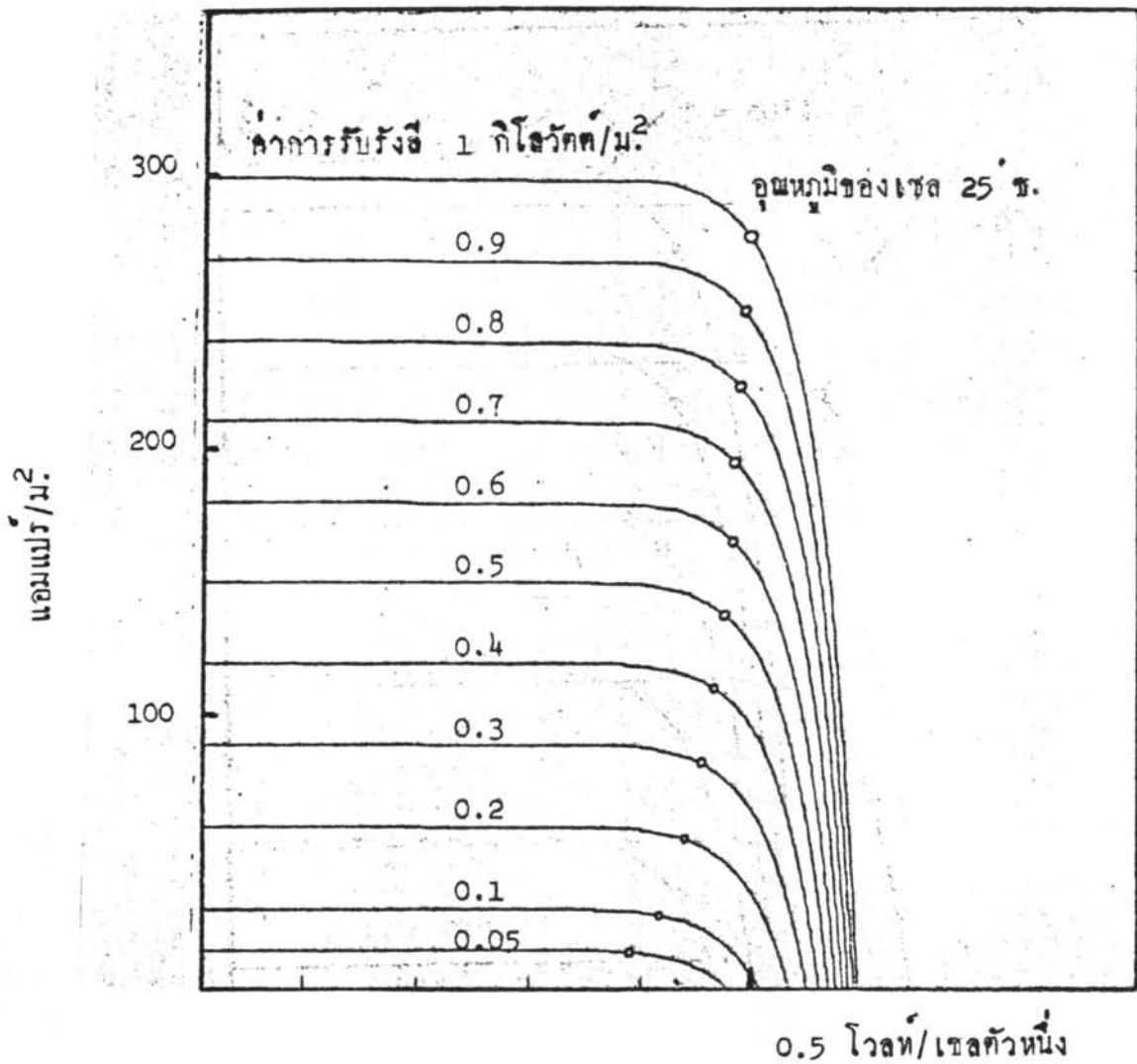
สมการ (2.4) เป็นสมการของเซลล์แสงอาทิตย์ที่แสดงความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันเมื่ออุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์คงที่

คุณลักษณะกระแสและแรงดันของเซลล์แสงอาทิตย์ [3]

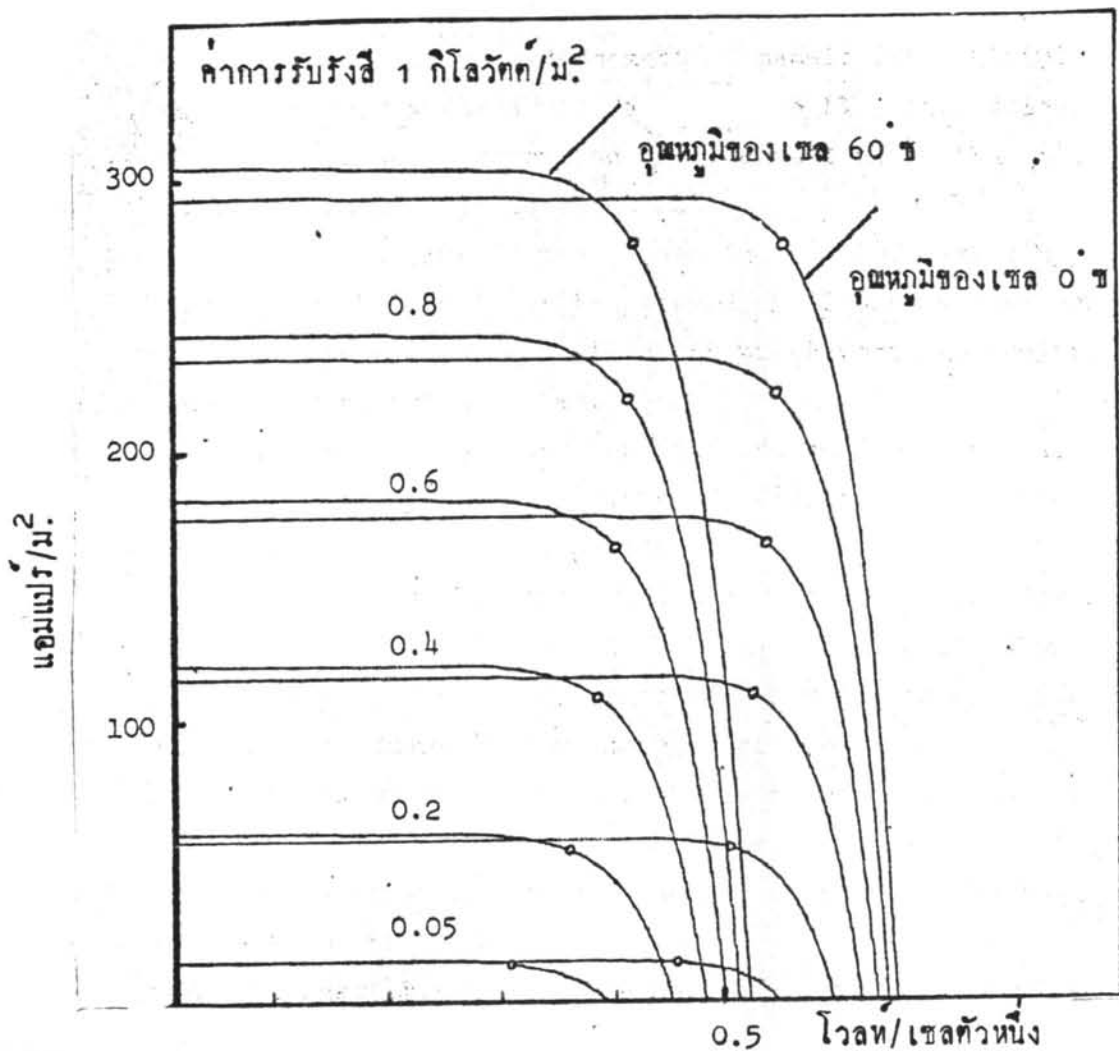
จากสมการที่ (2.4) แสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิคงที่ แต่ค่าการรับรังสีที่ตกอยู่บนเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ได้เส้นคุณลักษณะกระแสและแรงดันเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังภาพที่ 2.4 แกน x เป็นค่าแรงดัน ส่วนแกน y เป็นค่าความหนาแน่นกระแส (current density) มีหน่วยเป็นแอมแปร์ต่อตารางเมตร

ถ้าเราทราบพื้นที่รับแสงของเซลล์ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. มีพื้นที่ 1.9635×10^{-3} ตารางเมตร เราก็สามารถหาค่ากระแสจากเซลล์ โดยนำความหนาแน่นกระแสไปคูณกับพื้นที่เซลล์นั้น

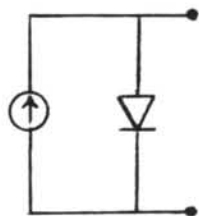
ตัวอย่าง ที่ค่าการรับรังสี 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ความหนาแน่นของกระแสลัดวงจร (แรงดันมีค่าศูนย์) มีประมาณ 300 แอมแปร์ต่อตารางเมตร เซลล์เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. มีค่ากระแสลัดวงจร $300 \times 1.9635 \times 10^{-3} = 0.589$ แอมแปร์



ภาพที่ 2.4 แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงค่าการรับรังสีต่อเส้นคุณลักษณะกระแสและแรงดันของเซลล์แสงอาทิตย์ จุกกลมแสดงถึงค่าที่เซลล์แสงอาทิตย์ให้กำลังงานสูงสุดที่ค่าการรับรังสีนั้น ๆ



ภาพที่ 2.5 ผลของอุณหภูมิต่อเซลล์แสงอาทิตย์



ภาพที่ 2.6 วงจรแทนเซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่าย



จากภาพที่ 2.4 สังเกตเห็นว่าที่จุดกำลังงานสูงสุดนั้น เซลแสงอาทิตย์ให้แรงดันประมาณ 0.5 โวลต์ และแรงดันเปิดวงจร (กระแสมีค่าศูนย์) มีค่าสูงสุดไม่เกิน 0.7 โวลต์ ผลของอุณหภูมิคือเส้นคุณลักษณะกระแสและแรงดัน แสดงไว้ในภาพที่ 2.5

โดยทั่วไปที่ค่าการรับรังสีประมาณ 1,000 วัตต์/ตารางเมตร เซลแสงอาทิตย์เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. หนึ่งเซลล์ให้กำลังงานสูงสุดประมาณ 1 วัตต์ ส่วนเซลล์แสงอาทิตย์เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. หนึ่งเซลล์ให้กำลังงานสูงสุดประมาณ 0.25 วัตต์ ที่แรงดันประมาณ 0.5 โวลต์ ทั้งสองกรณี

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์หนึ่งเซลล์มีแรงดันประมาณ 0.5 โวลต์ ดังนั้นถ้าจะนำเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้กับภาระไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันมากกว่านี้จึงต้องนำเซลล์แสงอาทิตย์มาต่ออนุกรมกันให้แรงดันทั้งหมดสูงขึ้น ส่วนกระแสของเซลล์ขึ้นอยู่กับพื้นที่รับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์หนึ่งเซลล์นั้น เช่น เซลล์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. ให้กระแสได้สูงสุดประมาณ 2.5 แอมแปร์ ที่ค่าการรับรังสี 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ถ้าต้องการกระแสมากกว่าก็ต้องนำเซลล์มาต่อขนานกันให้กระแสมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสแต่ละเซลล์ที่ขนานกันนั้น

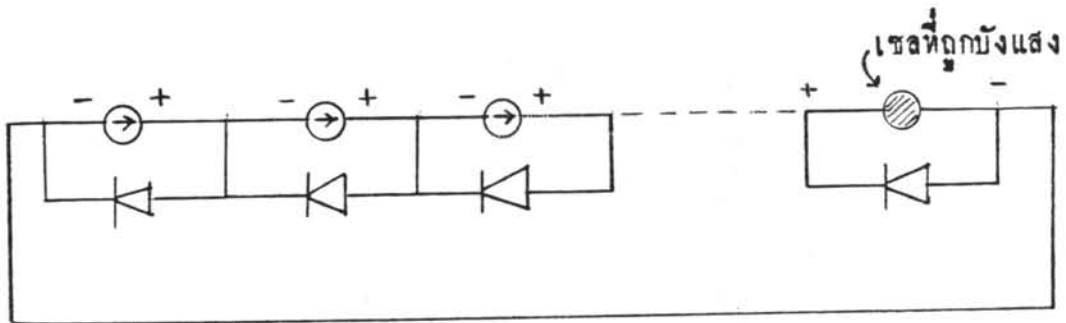
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์อนุกรมและแบบเซลล์ขนาน

ถ้าเซลล์แสงอาทิตย์ต่อกันแบบอนุกรม เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเซลล์ในกรณีเกิดเงาบังบนเซลล์แสงอาทิตย์ นั่นคือ ไม่ให้แรงดันของเซลล์ที่ไม่ถูกบังแสงไปทำอันตรายต่อเซลล์ที่ถูกบังแสงนั้น วิธีการ คือต้องจำกัดจำนวนเซลล์ที่จะมาต่ออนุกรมกัน หรือใช้ไดโอดเซาราย

เพื่อจ่ายต่อการอธิบาย เซลล์แสงอาทิตย์หนึ่งเซลล์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ตามภาพที่ 2.6 คือเป็นแหล่งจ่ายกระแส และมีไดโอดต่อขนานอยู่

การถูกไบอัสกลับของเซลล์แสงอาทิตย์

การถูกไบอัสกลับของเซลล์อาจนำไปสู่ความเสียหายของตัวเซลล์ แม้เพียงหนึ่งเซลล์ก็ทำให้แผงที่เซลล์อนุกรมกันเสียหายทั้งแผง คือ ให้กำลังงานออกมาน้อย [3] การไบอัสกลับเกิดขึ้นในกรณีที่เซลล์หลายเซลล์ต่ออนุกรมกันตามภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2.7 แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์อนุกรมกัน

กรณีรุนแรงที่สุดคือแผงถูกลัดวงจร เซลล์ที่ถูกบังยอมถูกไบอัสกลับด้วยแรงดันค่าหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากับผลบวกของแรงดันจากแต่ละเซลล์ที่ได้รับแสง ค่าแรงดันจากแต่ละเซลล์มีค่าเกือบใกล้เคียงกับค่าแรงดันเปิดวงจร คือ ประมาณ 0.5 โวลต์ เพราะว่าเซลล์ที่ถูกบังแสงนั้น ขณะนี้เป็นเหมือนการะไฟฟ้าซึ่งมีความต้านทานมาก การออกแบบให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์อนุกรมมีความปลอดภัย คือ ผลบวกของแรงดันจากเซลล์ที่ได้รับแสงต้องน้อยกว่าค่าแรงดันพัง (Breakdown voltage) ของเซลล์ที่ถูกบังแสงนั้น

นั่นคือ

$$(n-1)V_{oc} < V_{br} \dots\dots\dots (2.5)$$

n คือ จำนวนเซลล์ที่ต่ออนุกรมกันในแผงนั้น

V_{oc} คือ แรงดันเปิดวงจรของเซลล์ ประมาณ 0.5 โวลต์

V_{br} คือ แรงดันพังของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อถูกไบอัสกลับ ซึ่งค่าที่ปลอดภัยของเซลล์ คือ เซลล์ไม่ควรถูกไบอัสกลับด้วยแรงดัน $V_{br} \geq 20$ โวลต์ [3]

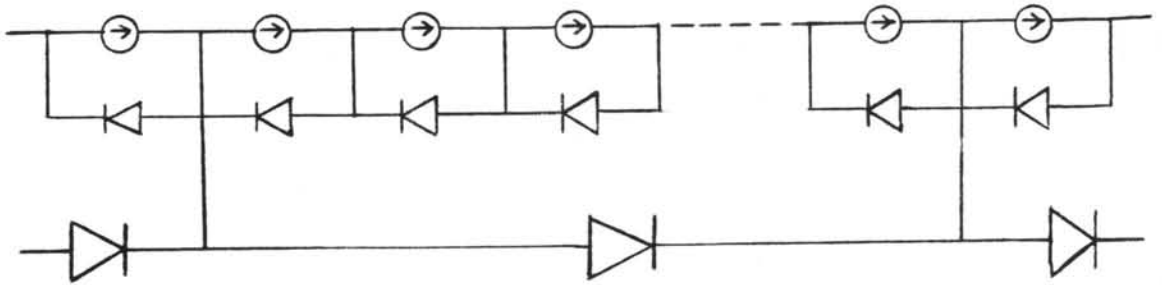
ถ้าจะลองออกแบบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์อนุกรมว่า ควรมีเซลล์ต่อกันไม่เกินกี่เซลล์ ก็คำนวณหา n จาก อสมการที่ (2.5)

$$(n-1) \times 0.5 < 20$$

$$0.5 n < 20.5$$

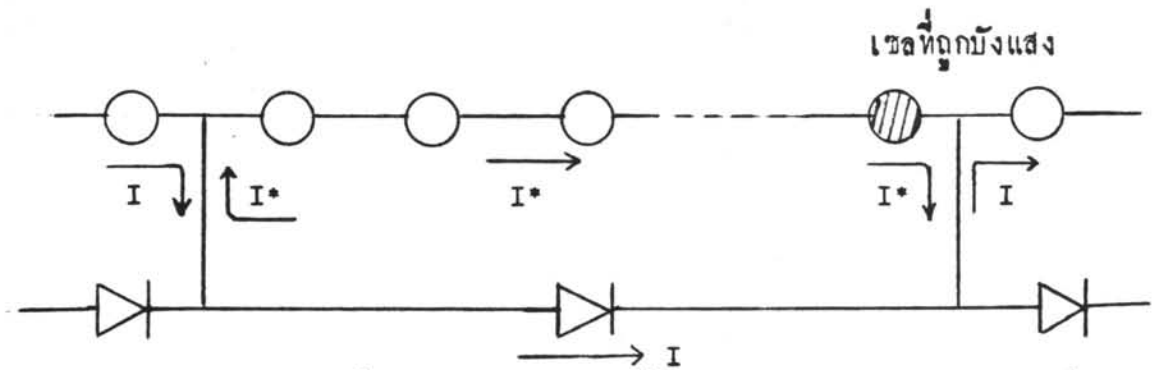
$$n < 41 \text{ เซล}$$

แต่ถ้าต้องการแรงดันสูง ๆ จากแผงแบบเซลล์อนุกรม ก็ทำได้โดยต่อไดโอด (Bypass diode) ขนานกับเซลล์อนุกรมกับ n เซลล์นั้น โดยให้ไดโอดถูกไบอัสกลับ ขณะที่เซลล์ทุกเซลล์จ่ายกระแสตามปกติ ตามภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต่อยบายพาสไดโอดไว้

เมื่อมีเซลล์หนึ่งถูกบังแสง ตามภาพที่ 2.9 กระแส I^* ของแผงที่มีเซลล์ถูกบังแสงมีค่าต่ำ เซลล์ที่ถูกบังนี้ถูกไบอัสกลับด้วยแรงดันจากเซลล์ที่ทำงานตามปกติในแผงนั้น บายพาสไดโอดถูกไบอัสตาม (Forward-bias) ด้วยกระแส I จากแผงอื่น บายพาสไดโอดเสมือนถูกลัดวงจร ทำให้แผงที่มีเซลล์ถูกบังแสงมีแรงดันไบอัสกลับจากเซลล์ในแผงนี้เท่านั้น แรงดันจากเซลล์นอกแผงจะไม่มีส่วนในการไบอัสกลับต่อเซลล์ที่ถูกบังแสงนี้เลย จึงเกิดความผิดปกติต่อแผงนั้น ถ้าออกแบบแผงตามสมการที่ (2.5) แล้ว



ภาพที่ 2.9 แสดงกระแสที่ไหลในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขณะที่เซลล์

หนึ่งถูกบังแสง

การถูกไบอัสตามของเซลล์แสงอาทิตย์

ตามภาพที่ 2.10 ก) เซลล์แสงอาทิตย์หลาย ๆ เซลล์ต่อขนานกันอยู่ เมื่อเซลล์หนึ่งถูกบังแสง เซลล์นั้นย่อมถูกไบอัสตาม [3] อธิบายได้ตามภาพที่ 2.10 ข) ซึ่งเป็นวงจรสมมูลย์ ของแผงเซลล์แบบต่อขนาน จะเห็นว่าเซลล์ที่ถูกบังแสงนั้น ขณะนี้เปรียบเสมือนไดโอดซึ่งถูกไบอัสตามด้วยแรงดัน V จากเซลล์ที่ทำงานตามปกติ

สมมติว่ามีเซลล์ n เซลล์ขนานกันอยู่ ย่อมได้ว่า

$$(n-1)(I_{sc} - I_d) = I \quad \dots\dots\dots (2.6)$$

- I_{sc} คือ กระแสลัดวงจรของเซลล์หนึ่งเซลล์
- I_d คือ กระแสไดโอดภายในเซลล์ (Internal diode current)
- I คือ กระแสไหลในเซลล์ที่ถูกบังแสง

ถ้าเซลล์ n เซลล์ มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ (identical) แรงดัน V คร่อมไดโอดของเซลล์ปกติ ก็ย่อมเป็นแรงดันของเซลล์ที่ถูกบังแสง ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านไดโอด I_d ก็เท่ากับ I ด้วย

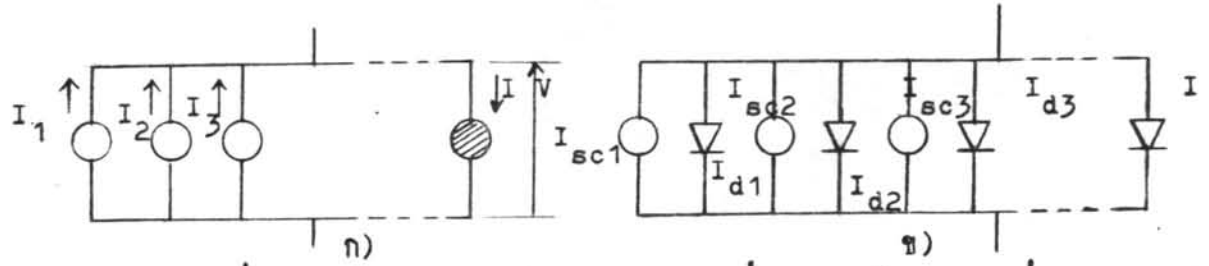
เราทราบว่า จากคุณสมบัติของไดโอด ตามสมการ (2.1)

$$I = I_o (\exp \frac{V}{AV_t} - 1)$$

โดยการประมาณให้ I_o มีค่าน้อยมาก, $I = I_o (\exp \frac{V}{AV_t}) \quad \dots\dots\dots (2.7)$

จากสมการ (2.6) และ $I = I_d$ ได้ว่า

$$I = \frac{n-1}{n} I_{sc} \quad \dots\dots\dots (2.8)$$



ภาพที่ 2.10 ก) การถูกไบอัสตามของเซลล์ที่ถูกบังแสงในแผงเซลล์ต่อขนาน
ข) วงจรสมมูลย์ของ ก)

จากสมการ (2.8) จะเห็นว่าถ้าจำนวนเซลล์ที่ขนานกันมีจำนวนมากใกล้อนันต์ (infinity) กระแสที่ไหลในเซลล์ที่ถูกบังแสงยอมเข้าใกล้กระแสลัดวงจรของเซลล์ พลังงานแฉความร้อน (Power dissipation) ในกรณีนี้เป็นไปตาม

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_d = I_{sc} V_{oc} = \frac{P_m}{F.F} \quad \dots \quad (2.9)$$

P_d คือ พลังงานแฉความร้อน

P_m คือ พลังงานสูงสุดจากเซลล์ที่ได้รับแสง

$F.F$ คือ ฟิลล์แฟกเตอร์ (Fill factor) ของเซลล์ มีค่าเท่ากับผลคูณของกระแสและแรงดันที่จุดกำลังงานสูงสุดหารด้วยผลคูณของกระแสลัดวงจรและแรงดันเปิดวงจร

$$F.F = \frac{I_m V_m}{I_{sc} V_{oc}} = \frac{P_m}{I_{sc} V_{oc}}$$

ค่าพลังงาน P_d จากสมการนี้มีค่าต่ำ ไม่มากพอที่จะทำให้เซลล์เสียหายได้ แต่ถ้าเซลล์มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน (not identical) กรณีรัยแรงที่สุกเกิดขึ้นกับเซลล์ที่ถูกบังแสงซึ่งให้แรงดันเปิดวงจรน้อยที่สุด จากสมการที่ (2.7) ได้ว่า

$$V_{oc} = AV_t \ln \frac{I_{sc}}{I_o} \quad \dots \quad (2.10)$$

ถ้า V_{oc}^* เป็นแรงดันเปิดวงจรของเซลล์ที่ถูกบังแสง ซึ่ง V_{oc}^* นี้ มีค่าน้อยกว่า V_{oc} ของเซลล์อื่นที่ได้รับแสง

$$V_{oc}^* = AV_t \ln \frac{I_{sc}}{I_o^*} \quad \dots \quad (2.11)$$

จากสมการที่ (2.10), (2.11)

$$\Delta V_{oc} = V_{oc} - V_{oc}^* = AV_t \ln \frac{I_o^*}{I_o} \quad \dots \quad (2.12)$$

จากสมการ (2.6) เขียนใหม่ได้ว่า

$$(n-1)(I_{sc} - I_o \exp \frac{V}{AV_t}) = I_o^* \exp \frac{V}{AV_t} \quad \dots \quad (2.13)$$

จากสมการที่ (2.13)

$$\begin{aligned}
 (n-1)I_{sc} - (n-1)(I_o \exp \frac{V}{AV_t}) &= I_o^* \exp \frac{V}{AV_t} \\
 (n-1)I_{sc} &= \frac{I_o^* \exp \frac{V}{AV_t}}{I_o} [(n-1)I_o + I_o^*] \\
 (n-1)I_{sc} &= \frac{I}{I_o} [(n-1)I_o + I_o^*] \\
 I &= \frac{(n-1)I_{sc}}{(n-1)\frac{I_o}{I_o^*} + 1} \dots\dots\dots (2.14)
 \end{aligned}$$

จากสมการที่ (2.12)
$$I = \frac{(n-1)}{(n-1)\exp -\frac{\Delta V_{oc}}{AV_t} + 1} I_{sc} \dots\dots (2.15)$$

จากสมการที่ (2.15) นำไปหากระแสไหลในเซลล์ที่ถูกบังแสง เมื่อ V_{oc} ของเซลล์ไม่เท่ากับเซลล์ที่ได้รับความสว่าง

พลังงานแผ่ความร้อนในเซลล์ที่ถูกบังแสงหาได้จาก

$$P_d = VI = IAV_t \ln (I/I_o^*) \dots\dots\dots (2.16)$$

ซึ่ง I_o^* หาได้จากสมการที่ (2.11) เมื่อทราบ V_{oc}^*

จากสมการที่ (2.15) จะเห็นว่า เมื่อ ΔV_{oc} มีค่ามากขึ้น ค่าของ $\exp \left[-\frac{V_{oc}}{AV_t} \right]$ ย่อมมีค่าลดลง และมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง ทำให้ค่า I มีค่ามากกว่า I_{sc} ดังนั้นในการต่อแผงเซลล์แบบเซลล์ขนานกันต้องคำนึงถึงแรงดันจากเซลล์ (V_{oc}) ไม่ให้แตกต่างกันมาก

จากสมการที่ (2.15) ถ้าให้ $I = I_{sc}$ นั่นคือ

$$\frac{n-1}{(n-1)\exp \left[-\frac{\Delta V_{oc}}{AV_t} \right] + 1} = 1 \text{ นำไปหาค่า } n \text{ ได้}$$

แถวแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ในท้องตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ที่ซื้อขายกัน มักทำเป็นแถวเซลล์แบบเซลล์อนุกรมกัน มีแรงดันเปิดวงจรของแผงต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับจำนวนเซลล์ที่ต่ออนุกรมกันนั้น กระแสลัดวงจรก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่รับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์หนึ่งเซลล์บนแผงนั้น ทั้งแรงดันและกระแสจากเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับค่าการรับรังสีที่แสงอาทิตย์ตกลงบนเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย

กำลังงานที่ได้จากแผงก็ขึ้นอยู่กับกระแสและแรงดันจากเซลล์แสงอาทิตย์ แผงที่ผลิตออกจำหน่ายมีกำลังงานตั้งแต่ 2 วัตต์ไปจนถึงประมาณ 35 วัตต์ ตัวอย่างเช่น แผงเซลล์แบบเซลล์อนุกรมของบริษัทหนึ่งในอเมริกา มีเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. จำนวน 35 เซลล์ต่ออนุกรมกัน หรือ 33 เซลล์ต่ออนุกรมกัน มีคุณสมบัติตามตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงคุณสมบัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทผลิตแห่งหนึ่ง ซึ่งแผงนี้มีจำนวนเซลล์ที่ต่ออนุกรมกัน 35 เซลล์ และ 33 เซลล์ เส้นผ่าศูนย์กลางของเซลล์ประมาณ 10 ซม. ที่ค่าการรับรังสี 1000 วัตต์/ม²

	อุณหภูมิ 28° ซ.		อุณหภูมิ 45° ซ.	
	35 เซลล์	33 เซลล์	35 เซลล์	33 เซลล์
แรงดันเปิดวงจร (โวลท์)	20.3	20.0	18.9	18.0
กระแสลัดวงจร (แอมแปร์)	2.5	2.5	2.5	2.5
แรงดันที่จุดกำลังงานสูงสุด (โวลท์)	16.1	16.0	14.6	14.6
กระแสที่จุดกำลังงานสูงสุด (แอมแปร์)	2.3	2.05	2.3	2.05
กำลังงานสูงสุด (วัตต์)	37.0	33.0	34.0	30.0

จาก ARCO Solar, Inc., 20554 Plummer Street
Chatsworth California 91311

จากข้อมูลในตารางที่ 2.1 ซึ่งให้เห็นว่า ถ้าภาระไฟฟ้าที่จะใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งจ่ายพลังงานนั้นต้องการกำลังงานมากกว่ากำลังงานที่ได้จากแผงเดียว ก็ต้องนำแผงเหล่านั้นมาต่อกัน และ/หรือ ขนานกัน เพื่อให้มีแรงดันและกระแสเหมาะสมกับความ ต้องการของภาระไฟฟ้า นั้น เราเรียกกลุ่มของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นี้ว่า แผงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar-cell array) เรียกย่อ ๆ ว่า แผงแผง (array) ถ้าเรามีเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์เดี่ยวหลาย ๆ เซลล์มาต่อขนานและ/หรืออนุกรมกัน ก็เรียกกลุ่มของเซลล์แสงอาทิตย์นี้ว่า แผงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เช่นกัน วงจรสมมูลย์ของแผงแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเขียนได้ดังภาพที่ 2.1 และสมการแสดงความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดัน ยังคงใช้สมการที่ 2.4 แต่ค่าคงที่ R_s , R_{sh} , I_o , λ และ K_{ph} เป็นค่าคงที่ของแผง ตัวอย่างการวิเคราะห์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์นี้ใช้กลุ่มของเซลล์แสงอาทิตย์ในการวิเคราะห์ ส่วนในการทดลองใช้กลุ่มของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบคิกคังคังที่ เพื่อทดลองรายละเอียด จะอยู่ในหัวข้อ การวิเคราะห์และหัวข้อการทดลองต่อไป